グラニュラー積層構造 FeZn0 スパッタ膜の構造特性

Local structure analysis of sputtered FeZnO thin films by XAFS

坂本 勲 ª, 安本 正人 b, **木下 量介 ª、中山 浩 ª、小池 正記 b、本多 茂男**。 片山 真祥 d、稲田 康宏 d

Isao Sakamoto^a, Masato Yasumoto^b, Ryosuke Kinoshita^a, Hiro Nakayama^a, Masaki Koike^b,

Shigeo Honda^c, Misaki Katayama^d, Yasuhiro Inada^d

"法政大学, ^b 産業技術総合研究所, ^c 島根大学, ^d 立命館大学

^a Hosei University, ^b AIST, ^C Shimane University, ^d Ritsumeikan University

Fe 原子を含む酸化亜鉛薄膜のような希薄磁性半導体は、室温で強磁性を示す可能性があるなど興味を持たれている。ヘリコンプラズマスパッタ装置を用いて作製された ZnO/FeZnO の積層構造薄膜 について、X 線吸収微細構造 (XAFS) で Fe についての電子構造を測定したことについて報告する。 その結果、Fe の K 吸収端 XANES 測定によって、ZnO/FeZnO 薄膜中には Fe²⁺と Fe³⁺が混合状態で あることが示された。

The dilute magnetic semiconductors (DMS) such as Fe-doping ZnO thin films are interested in the properties of room temperature ferromagnetism. We report on electronic structures measured by X-ray Absorption Fine Structure (XAFS) in ZnO/FeZnO multilayered thin films prepared by helicon plasma sputtering. As a result, it has been demonstrated that Fe ionic state is a mixture of Fe^{2+} and Fe^{3+} in the ZnO/FeZnO thin films from Fe K-edge X-ray Absorption Near-Edge Structure (XANES) spectra.

Keywords: dilute magnetic semiconductor (DMS), ferromagnetism, multilayer, XAFS, Fe K-XANES

背景と研究目的: 近年、遷移元素を含む半 導体材料は、室温以上の温度において強磁性 特性を示すなど半導体バルク材料とは異なっ た興味深い物性を示すことから注目されてい る。中でも、ZnOのような非磁性酸化物半導 体を母材として、Fe原子のような遷移金属原 子を微量含む「希薄磁性半導体」は、強磁性 状態の発現や磁気抵抗特性(MR特性)など 従来の半導体材料にはない諸特性から、将来 のスピントロニクス材料として期待されてい る[1,2]。そのために、世界各所において磁気 特性、構造特性等について研究が行われてい るが、相矛盾する結果が得られており、現在 のところ諸特性について信頼性の高い基礎的 データの更なる集積が望まれている段階にあ る。このような希薄磁性半導体の作製方法と しては、ゾル・ゲル法、イオン注入法などい ろいろな方法が試みられているが[3,4]、本研 究においては、他ではあまり研究例が見られ ない多層膜構造を持った希薄磁性半導体試料 を作製した。多層膜は、ヘリコンプラズマス

パッタ法を用いて、例えばFeZnO/ZnO多層膜 では、FeZnO層とZnO層を交互に 30 層積層し て作製している(Fig.1 参照)。この方法では、 FeZnO層の厚みを変化させることによって、 見かけ上のFe濃度を変化させた試料を作製す ることができる。このような組成に対する特 性の変化を原子レベルで理解するためには FeZnO層中でのFeおよびZnの電子状態や局所 構造を明らかにする必要がある。本研究にお いては、X-ray Absorption Fine Structure (XAFS)法を用いて、ZnO/FeZnO膜の構造と 構成しているFe原子の電子状態との関係を調 べた。

実験: 測定試料は、ZnO/FeZnO多層膜において積層構造を示す。多層膜は、FeとZnOの2 元ターゲットを用いてヘリコンプラズマスパッタ装置により作製した。Si基板上にZnO膜の付着中に、Fe膜の付着を一時的に同時に行うことによって、ZnO/FeZnO多層膜を作製した。そして、Feの付着時間を変えることによ って、見かけ上Fe濃度を変化させた試料を作 製した。Fig.1に作製したZnO/FeZnO多層膜の 構成図を示す。Feの濃度としては、1.2, 2.3, 3.3, 4.3, 5.4, 6.5 atom %と変えて作製した。これら の試料を用いて、立命館大学SRセンターBL-3 (XAFSビームライン)において、ZnO/FeZnO 膜の構成原子であるFeのK吸収端のX-ray Absorption Near Edge Structure (XANES)測定 を行った。XANES測定においては、測定試料 以外に標準試料としてFeO(+2), Fe₂O₃(+3)も 測定して、価数の比較を行った。BL-3では分 光結晶はSi(220)を用い、測定モードは蛍光測 定モードを利用した。測定エネルギー範囲は 7076~7180 eV、測定エネルギーステップは

0.35 eV/stepであった。入射X線に対して90°の 角度で蛍光検出器(3素子SSD)を設置して測 定を行った。

<u>結果、および、考察</u>: Fig. 2 には、ZnO/ Fe_xZn_{1-x}O (X=0.023), ZnO/Fe_xZn_{1-x}O (X=0.065), FeO, Fe₂O₃のFe K吸収端のXANES測定結果を 示す。このスペクトルから、FeOは 2 価、Fe₂O₃ は 3 価であることから、ZnO/Fe_xZn_{1-x}O (X=0.023), ZnO/Fe_xZn_{1-x}O (X=0.065)では、それ ぞれ 2 価Feと 3 価Feが混合状態であることが 示された。また、7110 eV近傍にFeのpre-edge ピークが測定された。測定試料に含まれるFe の濃度による吸収端エネルギーのシフトが観 測され、FeZnO層厚の増加に伴い、Feの価数 の割合 (Fe³⁺/Fe²⁺)が減少することが分かっ た。すなわち、FeZnO層厚の増加に伴い、Fe²⁺ の割合が増加した。

<u>文</u>献

[1] I. Sakamoto, S. Honda, H. Tanoue, M. Koike and S. Purwanto, J. Magn. Mag. Mater 290-291 (2005)78-81.

[2] R. Kinoshita, I. Sakamoto, N. Hayashi, K. Nomura, S. Honda, T. Ishida, S. Iio, H. Tashiro and T. Toriyama, Jpn. J. Appl. Phys. 50 (2011) 01BE01.

[3] L. Xu and X. Li, Journal of Crystal Growth 312 (2010)851.

[4] R. Saleh, S. Purbo and A. Fishli, J. Magn. Mag. Mater 324 (2012) 665-670.

<u>論文・学会等発表(予定)</u>

[C]口頭発表

[1]木下量介,中山浩,坂本勲,安本正人,小 池正記,本多茂男,2011 年秋季応用物理学会 学術講演会、2011 年9月、山形大学

[2] H. Nakayama, T. Ishida, R. Kinoshita, S.

Purwanto, I. Sakamoto, S. Honda, M. Koike, M. Yasumoto, N. Hayashi and T. Toriyama, ISPlasma 2012、2012 年 3 月、中部大学 [3]橋岡弘樹、神野達哉、岡嵜聡、坂本勲、小 池正記、安本正人、林伸行、本多茂男、第 13 回メスバウアー分光研究会シンポジウム、 2012 年 3 月、東京大学 [4]中山浩,坂本勲,安本正人,小池正記,本 多茂男, 2012 年秋季応用物理学会学術講演 会、2012 年 9 月、愛媛大学(予定)



Fig. 1. Structure of ZnO/FeZnO multilayer.



Fig. 2. Observed Fe K-edge XANES spectra of multilayer $Fe_XZn_{1-X}O$, FeO and Fe_2O_3 thin films.